PZT 薄膜プロセスモニターPrと d_{33,f}の比較

Comparing Pr and $d_{33,f}$ by process monitor on PZT thin films

産総研¹, ⁰牧本なつみ¹, 伊藤 寿浩^{1,2}, 小林健¹

AIST¹, Tokyo Univ.², ^oN. Makimoto¹, T. Itoh^{1,2}, T. Kobayashi¹, E-mail:natsumi-makimoto@aist.go.jp

【はじめに】

圧電 MEMS プロセスにおいて[1]、PZT 膜膜を 微細加工する際、プロセスモニターとして従来は 残留分極 Pr を指標とするのが主であった。前回 我々は、圧電定数 d_{33f} が実デバイスで必要な圧 電定数 d₃₁ と一定の関係にあり、MEMS プロセス の早い段階から測定できることを報告した[2]。そ れゆえ、今回は、圧電定数 d_{33f} のプロセスモニタ ーとしての適性を、残留分極 Pr と比較し、プロセ スモニター行う場合の,より有効な手段に関する調 査を行った。

【実験方法】

(100)/(001)配向した Pb(ZrO_{0.52}, TiO_{0.48})O₃ 薄膜(膜 厚 1.80µm、1.84µm)を、(111)Pt/Ti/SiO₂/SOI 基板 上にそれぞれ形成し、サイズ ϕ 400µm のドットを作 製した。この 2 枚のウェハに関し、PZT 薄膜エッチ ング後から、基板貫通エッチング後まで、各プロ セス毎に、ウェハ面内を一定の間隔で同じ位置の ドットを、ダブルビームレーザー干渉計 (DBLI)に より 1000kHz、±30V で測定し Pr と d_{33f} の変化を 観察した。これらの結果から、ウェハ面内の Pr と d_{33f} の面内均一性とプロセスモニターの適性調査 を行った。

【結果および考察】

図 1(a),(b)の結果より、それぞれウェハの PZT 薄 膜エッチング後、±30V で測定したドットに下部電 極、熱酸化膜エッチングを行い、このプロセス後に ±30V で測定すると、Pr は約 10%減少し、同じド ットで継続して測定を続けると、基板貫通エッチン グ後には 20%近く減少し、2 枚それぞれ同様の結 果であることが分かった。また、ウェハ面内で、そ れぞれ最大値と外周部の最小値では30%程度の 差があり、この傾向は Pr が減少しながらも、基板 貫通エッチング後まで継続して見られた。そこで、 他の条件でも Pr が減少するのかどうか、各プロセ ス毎に、未測定ドットについても±30V で測定し、 継続して測定しているドットの Prと比較した(図 2)。 その結果、初めて測定したドットの Pr は、PZT 薄 膜エッチング後の Pr と同程度であり、減少してい ないことが判明した。一方、図 3(a),(b)の d_{33,f} の場 合は、PZT 薄膜エッチング後に得た d_{33.f}が、基板 貫通エッチングまで、それぞれのウェハで変化な く(減少率 0%)安定していることが分かった。Pr と d33.fのそれぞれの結果から、プロセス中に電気的

な刺激を受けたドットは、熱やプラズマ処理により Prが減少し、初期 Pr保持性のモニタリングには、 常に新しいドットを測定する必要があることが判明 した。それゆえ、測定ドットが多数必要な Pr に比 べ、圧電定数 d_{33f}の方がプロセスモニターとして、 効率的であるとことが分かった。







Fig.2 Process monitor by remnant polarization *Pr* as a function of process steps.



Fig.3. Process monitor by piezoelectric constant d as a function of wafer x-position of (a) no.1, (b) no.2.

【参考文献】

[1] T. Kobayashi et al., J. Micromech. Microeng., 18, 115007 (2008)

[2] 牧本ら,第62回春季応物,11p-P4-9 【謝辞】

本研究は、国立研究開発法人新エネルギー・産業 技術開発機構(NEDO)の委託業務の結果得られた ものである。